

Содержание

● Электронные свойства полупроводников

Боднарь И.В.

Тепловое расширение и теплопроводность соединений In_2S_3 , CuIn_5S_8 и твердых растворов $(\text{CuIn}_5\text{S}_8)_{1-x}(\text{In}_2\text{S}_3)_x$. 577

Шалдин Ю.В., Matyjasik S.

Пирозлектрические свойства широкозонного полупроводника CdS в области низких температур 582

Джафаров М.А., Насиров Э.Ф., Мамедова С.А.

Отрицательная фотопроводимость в пленках твердых растворов соединений $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ 590

Нгуен Х.Ф., Козюхин С.А., Певцов А.Б.

Влияние висмута на оптические свойства тонких пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ 597

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Зайцев Д.А., Сейсян Р.П.

Оптическое пропускание тонких пластин GaAs при лазерной накачке в область экситонных резонансов и континуума состояний: экситон-экситонное взаимодействие 604

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Ткач Н.В., Сети Ю.А.

Каналы прозрачности и вольт-амперная характеристика двухбарьерной наносистемы в постоянном электрическом и электромагнитном полях произвольной напряженности 610

Davatolhagh S., Khordad R., Jafari A.R.

Intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in spherical hydrogenic antidots 616

Зуев В.В., Григорьев С.Н., Романов Р.И., Фоминский В.Ю., Григорьев В.В.

Об особенностях детектирования водорода полупроводниковой структурой, полученной на подложке 6H-SiC комбинированным методом ионной имплантации и осаждения платины 621

Панкратов Е.Л., Гуськова О.П., Дроздов М.Н., Абросимова Н.Д., Воротынцев В.М.

Аномальное распределение германия, имплантированного в диэлектрический слой структуры КНИ, после отжига радиационных дефектов 631

Mousavi Hamze

Heat capacity of hexagonal boron nitride sheet in Holstein model 636

Конакова Р.В., Коломыс А.Ф., Охрименко О.Б., Стрельчук В.В., Светличный А.М., Григорьев М.Н., Коноплев Б.Г.

Особенности спектров комбинационного рассеяния света структур кварц/Si и стекло/Si, обусловленные лазерным отжигом 639

Белёвский П.А., Винославский М.Н., Порошин В.Н., Байдусь Н.В., Звонков Б.Н.

Дальнее инфракрасное излучение из гетероструктур $n\text{-InGaAs/GaAs}$ с квантовыми ямами в сильных латеральных электрических полях в условиях инжекции 643

Грабов В.М., Демидов Е.В., Комаров В.А., Матвеев Д.Ю., Николаева А.А., Маркушевс Д., Константинов Е.В., Константинова Е.Е.

Размерный эффект в гальваномагнитных явлениях в пленках висмута, легированного теллуром 648

Mousavi Hamze, Behroozi Samad

The Hall conductivity of graphene 654

Галиев Г.Б., Климов Е.А., Ключков А.Н., Лаврухин Д.В., Пушкарев С.С., Мальцев П.П.

Фотоломинесцентные исследования метаморфных наногетероструктур $\text{In}_{0.7}\text{Al}_{0.3}\text{As}/\text{In}_{0.75}\text{Ga}_{0.25}\text{As}/\text{In}_{0.7}\text{Al}_{0.3}\text{As}$ на подложках GaAs 658

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Брантов С.К.

Полупроводниковое поведение нанокристаллического углерода 667

● Физика полупроводниковых приборов

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Калужный Н.А., Минтаиров С.А., Шварц М.З., Тимошина Н.Х., Саллий Р.А., Лантратов В.М.

Разностный способ получения темновой вольт-амперной характеристики и ее виды для остаточной (негенерирующей) части многопереходного солнечного элемента . . . 671

Коман Б.П.

Температурная селективность радиационного воздействия на кремниевые МОП-транзисторы 677

Лукашин В.М., Пашковский А.Б., Журавлев К.С., Торопов А.И., Лапин В.Г., Голант Е.И., Капралова А.А.

Перспективы развития мощных полевых транзисторов на гетероструктурах с донорно-акцепторным легированием 684

Саченко А.В., Костылев В.П., Кулиш Н.Р., Соколовский И.О., Шкретбий А.И.

Моделирование эффективности многопереходных солнечных элементов 693

Логунов А.А., Машин А.И., Строганов И.Ю.

Роль металлических контактов в солнечных элементах на основе диоксида титана и ди-(изотиоцианат)-бис-(2,2'-бипиридил-4,4'-дикарбоксилат)рутения(II) 702

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Шашкин И.С., Золотарев В.В., Пихтин Н.А., Тарасов И.С.

Анализ излучательной эффективности мощных полупроводниковых лазеров при выполнении пороговых условий генерации для замкнутой моды 705

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Пихтин Н.А., Золотарев В.В., Шашкин И.С., Лешко А.Ю., Лютецкий А.В., Растегаева М.Г., Тарасов И.С., Копьев П.С.

Многоволновый интегральный оптический модулятор лазерного излучения на основе полупроводниковых гетероструктур 710

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Васильева В.В., Пихтин Н.А., Рожков А.В., Горбатьюк А.В., Золотарев В.В., Веселов Д.А., Жаботинский А.В., Петухов А.А., Тарасов И.С., Багаев Т.А., Зверков М.В., Коняев В.П., Курнявко Ю.В., Ладугин М.А., Лобинцов А.В., Мармалюк А.А., Падалица А.А., Симарков В.А.

Эффективность управления мощного лазера-тиристора, излучающего в спектральном диапазоне 890–910 нм . . . 716